問題4 次のメモリに関する各設問に答えよ。

<設問1> 次の半導体メ 解答群から選べ。	モリに関する記述中の に入れるべき適切な字句を
	専用のメモリで、電源を切っても記憶内容は保持される不揮 のメモリには、工場出荷後に利用者が書き込めないものと、
(2) は読み書き メモリであり, (3) 高密度で消費電力が少7	可能なメモリで、電源を切ると記憶内容が消滅する揮発性の と (4) がある。 (3) はリフレッシュが必要だが、 いため、主記憶装置に使用され、 (4) は消費電力が大 不要で動作速度は高速なため、キャッシュメモリなどに使用
(1) , (2) の解答群 ア. RAM	イ. ROM
ウ. VRAM (3), (4)の解答群	工. VSAM
ア. DRAM ウ. SRAM	イ. HDD エ. UV-EPROM
<設問2> 次のメモリン 切な字句を解答群から追	クセスの高速化に関する記述中のことして入れるべき適べ。
実行中にCPUの待ち時間を用いる。CPUが主記憶確認し、存在しなければタがある確率を (5)	送速度は、CPUのデータ処理速度に比べて遅いためプログラムが発生する。この待ち時間を短縮するためにキャッシュメモリを置からデータを取り出すときには、まずキャッシュメモリをデー記憶装置から取り出す。このときキャッシュメモリにデーという。 クセス時間を10ナノ秒、主記憶装置のアクセス時間を60ナノる場合を考える。キャッシュメモリを使用する場合の平均ア
(7) ナノ秒短縮で また, CPUから主記憶 へ同時に書き込む (8	ナノ秒となり、キャッシュメモリを使用しない場合に比べてきる。 長置へデータを書き込む場合、主記憶装置とキャッシュメモリ 方式と、キャッシュメモリにだけ書き込み、主記憶装置 メモリを追い出される時にだけ書き込む (9) 方式があ

(5) の解答群

ア. LRU イ. NFP

ウ. ヒット率 エ. ブロック

(6), (7)の解答群

ア.8 イ. 10 ウ. 20

才. 50 工. 40 力. 60

(8), (9)の解答群

 ア. スワップアウト
 イ. スワップイン
 ウ. ライトスルー

 エ. ライトバック
 オ. ロールアウト
 カ. ロールイン